

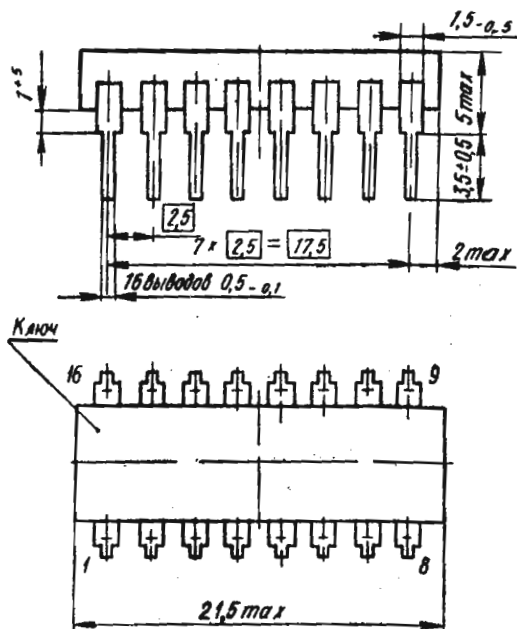
МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ КР559

Общие данные

Микросхемы выполнены в прямоугольных корпусах 238.16-2, 2140.20-1.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

МИКРОСХЕМ КР559ИП1, КР559ИП2, КР559ИП3,
КР559ИП4, КР559ИП7, КР559ИП6, КР559ИП11, КР559ИП12
(корпус 238.16-2)

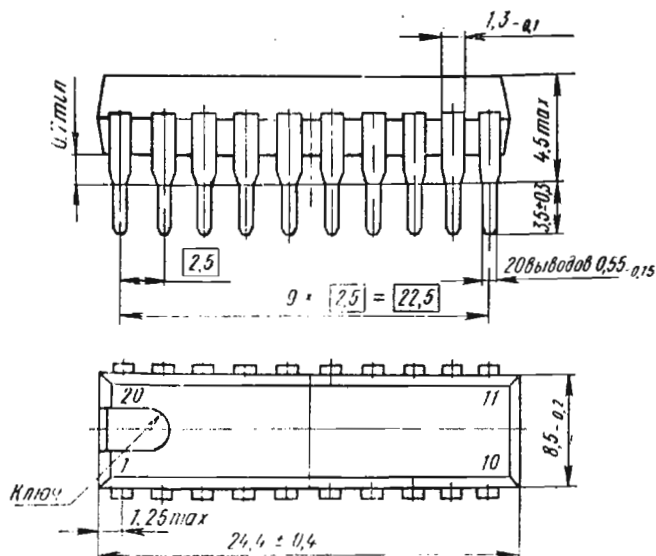


МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ КР559

Общие данные

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ

(корпус 2146.20-1)



Масса не более 1,8 г

Смещение осей выводов от номинального расположения $\pm 0,1$ мм (допуск зависимый). Нумерация выводов показана условно.

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц 1—2000

амплитуда ускорения, м/с^2 (g) 200 (20)

Механический удар одиночного действия:

пиковое ударное ускорение, м/с^2 (g) 1500 (150)

длительность действия ударного ускорения, мс 0,1—2,0

Механический удар многократного действия:

пиковое ударное ускорение, м/с^2 (g) 1500 (150)

длительность действия ударного ускорения, мс 1—5

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ КР559

Общие данные

Линейное ускорение, м/с ² (g)	5000 (500)
Повышенная рабочая температура среды, °C	70
Повышенная предельная температура среды, °C .	85
Пониженная рабочая температура среды, °C . . .	минус 10
Изменение температуры среды, °C	от минус 60 до +85

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка*, ч	50 000
Срок сохраняемости*, лет	20

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ГОСТ 18725—83 и требованиями, изложенными ниже.

Допустимое значение статического потенциала 30 В.

Для микросхем, подлежащих автоматизированной сборке, рекомендуется следующий режим:

температура припоя — не выше 265°C;

продолжительность пайки — не более 4 с;

число допускаемых переспаск выводов микросхем при проведении монтажных (сборочных) операций — не более трех;

используемые средства и химические реактивы — по ГОСТ 20.39.405—84.

Перед монтажом должны быть произведены обрезка и формовка микросхем.

Перед пайкой микросхемы устанавливают на керамические платы, предварительно нагретые до температуры 120°C, после чего потоками нагретых газов осуществляют нагрев микросхем и локальный нагрев мест пайки на керамической плате до расплавления припоя. При этом микросхему нагревают сверху (температура газа равна 220±10°C), а керамическую плату нагревают снизу (температура газа равна 380±20°C). Общий нагрев керамической платы с микросхемами не должен превышать температуры 250°C.

Длительность нахождения одной микросхемы при температуре расплавленного припоя не более 1 мин.

* В скобках даны значения для микросхем серии КР559.

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ КР559

Общие данные

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение питания, В:

максимальное	
для КР559ИП1, КР559ИП2	5,5
» остальных	5,25
минимальное	
для КР559ИП1, КР559ИП2	4,5
» остальных	4,75

Максимальное напряжение на выходе закрытой
микросхемы, В:

для КР559ИП1	3,5
» КР559ИП6 по выводам 2, 7, 9, 15	3,75
» КР559ИП3 по выводам 1, 4, 12, 15	4
» КР559ИП13, КР559ИП14 по выводам 1—8, 12—19	4

Минимальный выходной (вытекающий) ток, мА:

для КР559ИП1	минус 0,44
» КР559ИП12	минус 20
» КР559ИП13, КР559ИП14 по выводам 1—8	минус 3
» » » по выводам 12—19	минус 10
для КР559ИП2, КР559ВН1, КР559ВТ1, КР559ИП8	минус 1

Максимальный выходной (втекающий) ток, мА:

для КР559ИП1	70
» КР559ИП2	8
» КР559ИП3 по выводам 1, 4, 12, 15	70
» КР559ИП6 по выводам 1, 7, 9, 15	48
» КР559ИП8 по выводам 8, 9, 11, 12	70
» » » 6, 7, 17, 18	20
» » » по выводу 3	8
для КР559СК1	70
» КР559ИП11	8
» КР559ИП12	20
» КР559ИП13 по выводам 1—8	16
» КР559ИП14 по выводам 12—19	48

Дифференциальное напряжение на входах для

КР559ИП11 по выводам 1, 2, 6, 7, 9, 10, 14, 15, В:

максимальное	7
минимальное	минус 7

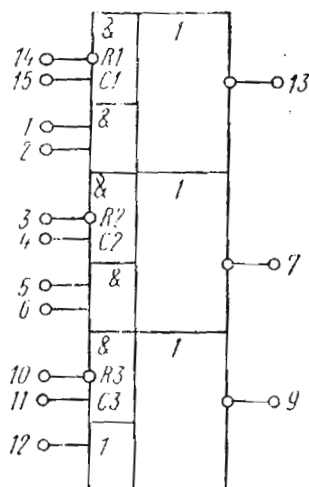
Напряжение синфазного сигнала для КР559ИП11 на

входах 1, 2, 6, 7, 9, 10, 14, 15, В:

максимальное	7
минимальное	минус 7

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

8 — общий
16 — 5 В



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре 25°C)

Напряжение питания, В	5±5%
Ток потребления при низком уровне выходного напряжения, мА, не более	86
Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения, мА, не более	58
Входной ток низкого уровня, мА, не более	1,4
Входной ток высокого уровня по выводам, мкА, не более:	
1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 15	10
3, 10, 14	120
Ток утечки на входе, мкА, не более	100
Выходное напряжение низкого уровня, В, не более	0,37
Выходное напряжение высокого уровня, В, не менее	2,8
Время задержки распространения при включении (выключении) по выводам от 3, 5 до 7; от 10, 12 до 9; от 1, 14 до 13, нс, не более	30